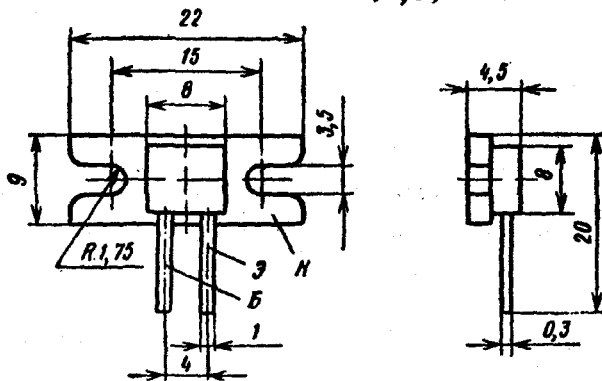


## КТ807 (А, Б), КТ807 (АМ, БМ)

Транзисторы кремниевые мезопланарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в генераторах кадровой и строчной разверток, усилителях низкой частоты, источниках вторичного электропитания. Выпускаются в металлопластмассовом (КТ807А, КТ807Б) и пластмассовом (КТ807АМ, КТ807БМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзисторов КТ807А, КТ807Б не более 2,5 г, КТ807АМ, КТ807БМ — не более 1 г.

КТ807 (А, Б)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ} = 5 \text{ В}$ ,  $I_{к} = 0,5 \text{ А}$ :

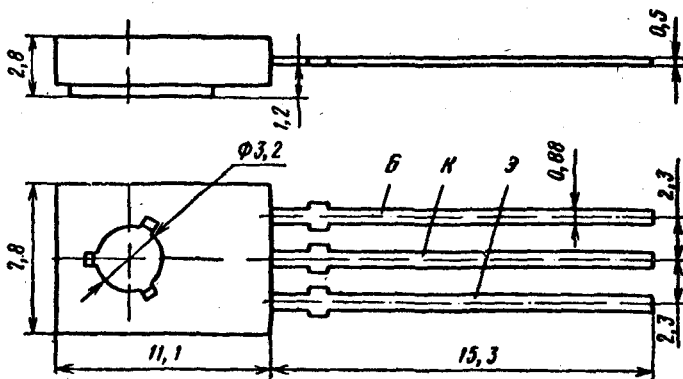
$T = +25^\circ \text{ С}$ :

КТ807А, КТ807АМ . . . . . 15...45  
 КТ807Б, КТ807БМ . . . . . 30...100

$T = +85^\circ \text{ С}$ :

КТ807А, КТ807АМ . . . . . 20...60  
 КТ807Б, КТ807БМ . . . . . 45...150

КТ807 (АМ, БМ)



Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ, не менее . . . . .	5 МГц
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{к} = 0,5 \text{ А}$ , $I_{б} = 0,1 \text{ А}$ , не более . . . . .	В
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{кэ} = 100 \text{ В}$ , $R_{бэ} = 10 \text{ Ом}$ , не более:	
$T = +25^\circ \text{ С}$ . . . . .	мА
$T = +85^\circ \text{ С}$ . . . . .	мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4 \text{ В}$ , не более . . . . .	мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{бэ} = 10 \text{ Ом}$ или $R_{бэ} = 1 \text{ КОм}$ и запирающем напряжении эмиттер — база 0,5 В . . . . .	100 В
Импульсное напряжение коллектор — эмиттер . . . . .	120 В
Постоянное напряжение эмиттер — база . . . . .	4 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	0,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_u < 1 \text{ мс}$ , и $Q \geq 2$ . . . . .	1,5 А
Постоянный ток базы . . . . .	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> при $T = -40 \dots +70^\circ \text{ С}$ . . . . .	10 Вт
Тепловое сопротивление переход — корпус . . . . .	$8^\circ \text{ С/Вт}$
Температура <i>p-n</i> перехода . . . . .	$+150^\circ \text{ С}$
Температура окружающей среды . . . . .	$-40 \dots +85^\circ \text{ С}$

<sup>1</sup> При  $T > +70^\circ \text{ С}$  мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, \text{ макс. Вт}} = (150 - T) / R_{T(n-k)}$$

Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба и пайки вывода не менее 5 мм. Радиус изгиба 1,5...2 мм. Пайка выводов должна осуществляться при температуре не более  $+250^\circ \text{ С}$  в течение не более 3 с.